### (19) **日本国特許庁(JP)**

# (12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2011-155123 (P2011-155123A)

(43) 公開日 平成23年8月11日(2011.8.11)

(51) Int.Cl.			F 1			テーマコード (参考)
HO1G	4/12	(2006.01)	HO1G	4/12	358	4 GO 3 1
CO4B	<i>35/468</i>	(2006.01)	C O 4 B	35/46	D	5EOO1
HO1G	4/30	(2006.01)	HO1G	4/30	301E	5E082
HO1B	3/12	(2006.01)	HO1B	3/12	303	5G3O3

		審査請求	未請求	請求項	の数 4	OL	(全	16 頁)
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2010-15431 (P2010-15431) 平成22年1月27日 (2010.1.27)	(71) 出願人	000006633 京セラ株式会社 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6番地					
		(72) 発明者	尾崎		) <u>                                      </u>	TTI VALISI	<i>γ</i> χμ, Ο	H 70
			鹿児島	早霧島市	国分山	下町1	番4号	京セ
			ラ株式	会社総合	研究所	内		
		(72) 発明者	山口	勝義				
				具霧島市			番4号	京セ
		(-a) <b>-</b> a <b>-</b> a -		会社総合	研究所	内		
		(72)発明者	井澤 -					
			鹿児島	具霧島市	国分山	下町1	番4号	京セ
			ラ株式	会社総合	研究所	内		
		Fターム (参	考) 4G03	31 AA03	AA06	AA07	AA08	AA11
				AA19	BA09	CA01	CA04	
			5E00	01 AB03	AE02	AE03	AE04	
						最	終頁に	続く

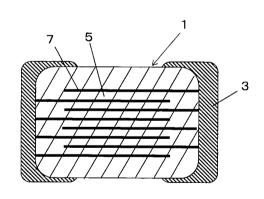
(54) 【発明の名称】 積層セラミックコンデンサ

### (57)【要約】

【課題】 低歪性を有するとともに、高温に保持したときの絶縁抵抗の変化率が小さく、高温負荷寿命に優れた積層セラミックコンデンサを提供する。

【解決手段】 誘電体層 5 が、イットリウム、マンガン、マグネシウム、イッテルビウムと、ディスプロシウム、ホルミウムおよびエルビウムから選ばれる少なくとも 1 種の希土類元素(RE)とを含有するとともに、チタン酸バリウムを主成分とする結晶相を主たる結晶相とし、該結晶相が立方晶系を主体とする結晶構造を有する結晶粒子により構成されているとともに、前記希土類元素が固溶した(Yb·RE) $_2$ TiO $_5$ 相を含有する誘電体磁器からなる。

【選択図】 図1



#### 【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

誘電体層と内部電極層とが交互に積層されたコンデンサ本体と、該コンデンサ本体の前記内部電極層が露出した端面に設けられた外部電極とを有する積層セラミックコンデンサであって、前記誘電体層が、イットリウム、マンガン、マグネシウム、イッテルビウムと、ディスプロシウム、ホルミウムおよびエルビウムから選ばれる少なくとも1種の希土類元素(RE)とを含有するとともに、チタン酸バリウムを主成分とする結晶相を主たる結晶相とし、該結晶相が立方晶系を主体とする結晶構造を有する結晶粒子により構成されているとともに、前記希土類元素が固溶した(Yb・RE)2Ti05相を含有する誘電体磁器からなることを特徴とする積層セラミックコンデンサ。

【請求項2】

前記誘電体層の X 線回折分析のリートベルト法解析において、バリウム 1 モルに対する前記( Y b・R E )  $_2$  T i O  $_5$  相の含有量が 0 . 0 0 1 6 モル以上であることを特徴とする請求項 1 に記載の積層セラミックコンデンサ。

### 【請求項3】

前記結晶粒子の平均粒径が 0 . 0 7 ~ 0 . 2 6 μ m であることを特徴とする請求項 2 に記載の積層セラミックコンデンサ。

#### 【請求項4】

### 【発明の詳細な説明】

#### 【技術分野】

[0001]

本発明は、チタン酸バリウムを主成分とする結晶粒子によって構成され、低電歪の積層 セラミックコンデンサに関する。

### 【背景技術】

[0002]

現在、モバイルコンピュータや携帯電話をはじめとするデジタル方式の電子機器の普及が目覚ましく、近い将来、地上デジタル放送が全国に展開されようとしている。地上デジタル放送用の受信機であるデジタル方式の電子機器として液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどがあるが、これらデジタル方式の電子機器には多くのLSIが用いられている。

[ 0 0 0 3 ]

そのため、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなど、これらデジタル方式の電子機器を構成する電源回路にはバイパス用のコンデンサが数多く実装されているが、このようなコンデンサとして好適なものとして、本出願人は、チタン酸バリウムを主成分とし、主な添加剤としてYbを含む結晶粒子によって構成される低電歪の誘電体磁器を誘電体層として持つ積層セラミックコンデンサを提案した(例えば、特許文献1を参照)。この積層セラミックコンデンサに用いられる誘電体磁器は、室温における比誘電率が200~100であり、かつ分極電荷が40nC/cm²以下と電歪性の小さいものであった。

#### 【先行技術文献】

## 【特許文献】

10

20

30

[0004]

【特許文献 1 】国際公開第 2 0 0 8 / 0 9 3 6 8 4 号パンフレット

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

ところが、特許文献 1 に開示された誘電体磁器を用いて積層セラミックコンデンサを作製した場合には、上述したように、低電歪の特性を有するものの、高温に保持したときの 絶縁抵抗の変化率(低下)が大きく、高温負荷寿命を満足しないという問題があった。

[0006]

従って、本発明は、低歪性を有するとともに、高温に保持したときの絶縁抵抗の変化率が小さく、高温負荷寿命に優れた積層セラミックコンデンサを提供することを目的とする

10

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明の積層セラミックコンデンサは、複数の誘電体層と複数の内部電極層とが交互に積層されたコンデンサ本体と、該コンデンサ本体の前記内部電極層が露出した端面に設けられた外部電極とを有する積層セラミックコンデンサであって、前記誘電体層が、イットリウム、マンガン、マグネシウム、イッテルビウムと、ディスプロシウム、ホルミウムおよびエルビウムから選ばれる少なくとも1種の希土類元素(RE)とを含有するとともに、チタン酸バリウムを主成分とする結晶相を主たる結晶相とし、該結晶相が立方晶系を主体とする結晶構造を有する結晶粒子により構成されているとともに、前記希土類元素が固溶した(Yb・RE)2TiO5相を含有する誘電体磁器からなることを特徴とする。

20

[00008]

上記積層セラミックコンデンサでは、前記誘電体層の X 線回折分析のリートベルト法解析において、バリウム 1 モルに対する前記( Y b ・ R E )  $_2$  T i O  $_5$  相の含有量が 0 . 0 0 1 6 モル以上であることが望ましい。

[0009]

上記積層セラミックコンデンサでは、前記結晶粒子の平均粒径が 0 . 0 7 ~ 0 . 2 6 µmであることが望ましい。

[0010]

30

上記積層セラミックコンデンサでは、前記結晶粒子の平均粒径が 0 . 0 8 ~ 0 . 2 2 μ m であるとともに、前記積層セラミックコンデンサを酸に溶解させて求められる元素の含有量が、バリウム 1 モルに対して、前記イットリウムが Y O 3 / 2 換算で 0 . 0 0 1 4 ~ 0 . 0 3 モル、前記マンガンが M n O 換算で 0 . 0 0 0 2 ~ 0 . 0 4 5 モル、前記マグネシウムが M g O 換算で 0 . 0 0 7 5 ~ 0 . 0 4 モル、前記イッテルビウムが Y b O 3 / 2 換算で 0 . 0 2 5 ~ 0 . 1 4 モル、前記希土類元素(R E )が 0 . 0 0 6 ~ 0 . 0 5 モルであり、かつ前記誘電体層の X 線回折分析のリートベルト法解析において、バリウム 1 モルに対する前記(Y b ・ R E ) 2 T i O 5 相の含有量が 0 . 0 0 2 4 ~ 0 . 0 0 8 モルであることが望ましい。

【発明の効果】

[0011]

本発明によれば、低歪性を有するとともに、高温に保持したときの絶縁抵抗の変化率が小さく、高温負荷寿命に優れた積層セラミックコンデンサを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

[ 0 0 1 2 ]

【図1】本発明の積層セラミックコンデンサの例を示す断面模式図である。

【発明を実施するための形態】

[0013]

本発明の積層セラミックコンデンサについて、図1の概略断面図をもとに詳細に説明する。図1は、本発明の積層セラミックコンデンサの一例を示す概略断面図である。

50

#### [0014]

この実施形態の積層セラミックコンデンサは、コンデンサ本体 1 の両端部に外部電極 3 が形成されている。外部電極 3 は、例えば、 C u もしくは C u と N i の合金ペーストを焼き付けて形成されている。

### [0015]

コンデンサ本体 1 は、誘電体磁器からなる複数の誘電体層 5 と複数の内部電極層 7 とが交互に積層され構成されている。図 1 では誘電体層 5 と内部電極層 7 との積層状態を単純化して示しているが、この実施形態の積層セラミックコンデンサは誘電体層 5 と内部電極層 7 とが数百層にも及ぶ積層体となっている。

### [0016]

誘電体磁器からなる誘電体層 5 は、結晶粒子と粒界相とから構成されており、その厚みは 1 0 μ m 以下、特に、 5 μ m 以下が望ましく、これにより積層セラミックコンデンサを小型、高容量化することが可能となる。なお、誘電体層 5 の厚みが 2 μ m 以上であると、静電容量のばらつきを小さくでき、また容量温度特性を安定化させることが可能になる。

#### [0017]

内部電極層 7 は、高積層化しても製造コストを抑制できるという点で、ニッケル(Ni)や銅(Cu)などの卑金属が望ましく、特に、この実施形態における誘電体層 5 との同時焼成が図れるという点でニッケル(Ni)がより望ましい。

### [0018]

この実施形態の積層セラミックコンデンサは、誘電体層5を構成する誘電体磁器が、チタン酸バリウムを主成分とする結晶相を主たる結晶相とし、該結晶相が立方晶系を主体とする結晶構造を有する結晶粒子により構成されている。また、この誘電体層5は、イットリウム、マンガン、マグネシウム、イッテルビウムと、ディスプロシウム、ホルミウムおよびエルビウムから選ばれる少なくとも1種の希土類元素(RE)とを含有する誘電体磁器からなる。さらに、この誘電体層5は、希土類元素が固溶した(Yb・RE)2TiO5相を含有する誘電体磁器からなる。

### [0019]

積層セラミックコンデンサが、上記成分を有し、結晶構造が立方晶系を主体とするものであり、また、誘電体磁器中に(Y b ・ R E) $_2$  T i O  $_5$  相を含有するものであると、高温での絶縁抵抗の変化率が - 9 5 %以内となり、高い高温負荷寿命に優れた低電歪特性を有する積層セラミックコンデンサとすることができる。

### [0020]

ここで、高温での絶縁抵抗の変化率は、積層セラミックコンデンサを温度125 に保持したときの、1分以内の絶縁抵抗をR0、同温度で10時間経過時の絶縁抵抗をR1としたときに、次式:((R1-R0)/R0)×100(%)で表される値である。

### [0021]

すなわち、この実施形態の積層セラミックコンデンサでは、誘電体層 5 が、チタン酸バリウムに、イットリウム、マンガン、マグネシウム、イッテルビウムと、ディスプロシウム、ホルミウムおよびエルビウムから選ばれる少なくとも 1 種の希土類元素(RE)とを固溶させて、立方晶系を主体とする結晶相により構成されるものであるが、その結晶相とともに、誘電体磁器中に所定量の(Yb・RE) 2 TiO 5 相が共存する。

#### [0022]

つまり、チタン酸バリウムに対して、イットリウム、マンガンおよびマグネシウムを含有させて、これにイッテルビウムを固溶させると、誘電特性として、低歪性(分極電荷(電圧 0 V における残留分極)が小さい)を示すものとなるが、このような誘電体磁器に、さらに、ディスプロシウム、ホルミウムおよびエルビウムから選ばれる少なくとも 1 種の希土類元素(RE)を固溶させて、イッテルビウムとディスプロシウム、ホルミウムおよびエルビウムから選ばれる少なくとも 1 種の希土類元素(RE)とチタン酸バリウムに含まれるチタン成分とから特定の複合酸化物を(Yb・RE)2 TiO5相として誘電体磁器中に主結晶相ととともに共存させた場合には、高温での絶縁抵抗の変化率を小さくする

10

20

30

40

ことができるのである。

### [0023]

ここで、チタン酸バリウムを主成分とする結晶相を主結晶相とし、この主結晶相が立方 晶系を主体とする結晶構造を有するとは、X線回折により求められる結晶構造として、2 = 9 7 ° ~ 1 0 4 ° の範囲(面指数(4 0 0))にピークを有しているもののことであ り、ペロブスカイト型結晶構造の面指数(4 0 0)のピークが分離していない程度の状態 を示すものをいう。

### [0024]

この実施形態の積層セラミックコンデンサでは、誘電体層 5 の X 線回折分析のリートベルト法解析におけるバリウム 1 モルに対する(Y b・R E)  $_2$  T i O  $_5$  相の含有量が 0 . 0 0 1 6 モル以上であることが望ましい。誘電体層 5 の X 線回折分析のリートベルト法解析におけるバリウム 1 モルに対する(Y b・R E)  $_2$  T i O  $_5$  相の含有量が 0 . 0 0 1 6 モル以上であると、高温での絶縁抵抗の変化率を - 9 1 %以内にすることができ、さらに高い高温負荷寿命に優れた低電歪特性の積層セラミックコンデンサとすることができる。

#### [0025]

この実施形態の積層セラミックコンデンサでは、結晶粒子の平均粒径が0.07~0. 26μmであることが望ましい。この実施形態の積層セラミックコンデンサにおいて、結晶粒子を特定の範囲にすると、室温(25)における比誘電率を720以上、分極電荷を36nC/cm²以下と低歪性の積層セラミックコンデンサとしての誘電特性をさらに高めることができるとともに、高温での絶縁抵抗の変化率を-89%以内にすることができ、さらに、温度:140 、直流電圧:150V、保持時間:20時間の条件の高温負荷寿命を満足させることができる。

### [0026]

### [0027]

なお、積層セラミックコンデンサを溶解させるために用いる酸としては、誘電体磁器を溶解することができるものであれば良く、塩酸、硝酸、硫酸、あるいは、硼酸および炭酸ナトリウムを含む塩酸の溶液等が好適である。

#### [0028]

また、誘電体層 5 の X 線回折分析のリートベルト法解析は、以下に示す方法で行う。まず、積層セラミックコンデンサを粉砕し、粉砕した誘電体磁器について X 線回折( P A P A P A P B

10

20

30

40

bic: Ia-3、No.206)、 $Yb_2TiO_5$ (cubic: F-43m、No.216)、MgO(cubic: Fm-3m、No.225)、BaO(tetrago nal: P4/nmm、No.129)、 $Ba_2TiSi_2O_8$ (cubic: tetrago nal: P4/nmm、No.129)、 $Ba_2TiSi_2O_8$ (cubic: tetrago mal: P4bn、moldon No.100)である。解析にあたっては、 $moldon Yb_2TiO_5$ 相の結晶ピークを基準として、そのピークシフト量を元に、格子定数の変化が認められることを確認するとともに、結晶粒子の断面について、分析装置(moldon EDS)を備えた透過電子顕微鏡を用いて、結晶粒子中に含まれる元素として、 $moldon Yb_2TiD_3$ 0)を確認して、誘電体磁器中に含まれている結晶相が( $moldon Yb_3TiD_3$ 1)とを含んでいることを確認して、誘電体磁器中に含まれている結晶相が( $moldon Yb_3TiD_3$ 1)とを含んでいることを同定する。

[0029]

誘電体磁器中の結晶相を構成する結晶粒子の平均粒径は、以下の手順で測定する。まず、焼成後のコンデンサ本体 1 である試料の破断面を研磨する。この後、研磨した試料を走査型電子顕微鏡を用いて内部組織の写真を撮り、その写真上で結晶粒子が 5 0 ~ 1 0 0 個入る円を描き、円内および円周にかかった結晶粒子を選択する。次いで、各結晶粒子の輪郭を画像処理して、各結晶粒子の面積を求め、同じ面積をもつ円に置き換えたときの直径を算出し、その平均値より求める。

[0030]

次に、本発明の積層セラミックコンデンサを製造する方法について説明する。

[0031]

この実施形態の積層セラミックコンデンサを製造する際に用いる誘電体粉末としては、 後述のチタン酸バリウムを主成分とし、これに所定の添加剤を加えて仮焼し、チタン酸バ リウムに各種の添加剤を固溶させた仮焼粉末と、他の添加剤を加えたものを用いる。

[0032]

誘電体粉末の元になる素原料粉末は、純度がいずれも99%以上のBaCO $_3$ 粉末、TiO $_2$ 粉末、Y $_2$ О $_3$ 粉末、MnCО $_3$ 粉末、Y $_2$ О $_3$ 粉末、Dy $_2$ О $_3$ 粉末、Ho $_2$ О $_3$ 粉末、およびEr $_2$ О $_3$ 粉末から選ばれる少なくとも1種の希土類元素(RE)の酸化物を用いる。これらの素原料粉末を、チタン酸バリウムを構成するバリウム1モルに対して、TiO $_2$ 粉末を0.97~0.99モル、Y $_2$ О $_3$ 粉末をYО $_3$ / $_2$ 換算で0.0004~0.06モル、MnCО $_3$ 粉末を0.001~0.05モル、Yb $_2$ О $_3$ 粉末をYbО $_3$ / $_2$ 換算で0.001~0.120モル、Dy $_2$ О $_3$ 粉末、Ho $_2$ О $_3$ 粉末、およびEr $_2$ О $_3$ 粉末から選ばれる少なくとも1種の希土類元素(RE)の酸化物を0.005~0.04モルの割合でそれぞれ配合して得られる。

[0033]

ただし、本発明においては、上述した Y b  $_2$  O  $_3$  の含有量のうち、一部の量(半分程度)は仮焼粉末を調製する際に先に添加し、残りの Y b  $_2$  O  $_3$  は得られた仮焼粉末に対して添加して仮焼粉末中において固溶していない Y b  $_2$  O  $_3$  を誘電体層 5 へ拡散させるようにする。

[0034]

 10

20

30

40

ンデンサにおける高温での絶縁抵抗の変化率を小さくすることができるのである。 なお、MgO粉末は、仮焼粉末への分散性をよくするという理由から、比表面積が 5 ~ 1 0 m<sup>2</sup>/gのものを用いるのがよい。

#### [0035]

次に、上述した素原料粉末を湿式混合し、乾燥させた後、温度850~1100 で仮焼し、次いで粉砕して仮焼粉末を得る。このときの仮焼粉末は、その結晶構造が立方晶系を主体とするものであり、また、平均粒径が0.04~0.15μmであることが好ましい。

### [0036]

仮焼粉末の平均粒径は、後述するように、仮焼粉末を電子顕微鏡用試料台上に分散させて走査型電子顕微鏡により写真を撮り、その写真上で結晶粒子が50~100個入る円を描き、円内および円周にかかった結晶粒子を選択する。次に、その写真に映し出されている仮焼粉末の輪郭を画像処理して各粒子の面積を求め、同じ面積をもつ円に置き換えたときの直径を算出し、その平均値より求める。

#### [0037]

次いで、得られた仮焼粉末100質量部に対して、MgO粉末を0.065~0.35質量部の割合だけ添加して誘電体粉末を得る。このときMgO粉末と同時にYb2O3粉末Dy2O3粉末、Ho2O3粉末およびEr2O3粉末から選ばれる少なくとも1種の希土類元素(RE)の酸化物も添加する。この場合、仮焼粉末に添加するYb2O3粉末量は仮焼粉末を調製する際に用いた量によって変動するが、仮焼粉末を調製する際に先に添加した量が、用いる全量の半分程度であれば、仮焼粉末100質量部に対して、0.1~5質量とするのがよい。

### [0038]

本発明では、上述のように、仮焼粉末に対して、比表面積の比較的大きいY b  $_2$  O  $_3$  粉末 D y  $_2$  O  $_3$  粉末、H o  $_2$  O  $_3$  粉末および E r  $_2$  O  $_3$  粉末から選ばれる少なくとも 1 種の希土類元素(RE)の酸化物を後添加して混合することにより、焼成時にY b  $_2$  O  $_3$  ならびに D y  $_2$  O  $_3$  、 H o  $_2$  O  $_3$  および E r  $_2$  O  $_3$  から選ばれる少なくとも 1 種の希土類元素(RE)の酸化物が誘電体磁器中に拡散して、誘電体磁器中において主成分を構成するチタンと反応して(Y b  $\cdot$  RE)  $_2$  T  $\dot{1}$  O  $_5$  相が生成しやすくなる。

### [0039]

そして、この誘電体粉末をポリビニルブチラール樹脂などの有機樹脂やトルエンおよびアルコールなどの溶媒とともにボールミルなどを用いてセラミックスラリを調製し、次いで、セラミックスラリをドクターブレード法やダイコータ法などのシート成形法を用いて基材上にセラミックグリーンシートを形成する。セラミックグリーンシートの厚みは誘電体層 5 の高容量化のための薄層化、高絶縁性を維持するという点で 1 ~ 2 0 µ m が好ましい。

### [0040]

なお、この実施形態の積層セラミックコンデンサを製造するに際しては、所望の誘電特性を維持できる範囲であれば、焼結助剤としてガラス粉末を添加しても良い。その添加量は、仮焼粉末に、MgO粉末を加えた誘電体粉末の合計量100質量部に対して0.5~4質量部が好ましい。

#### [0041]

次に、得られたセラミックグリーンシートの主面上に内部電極ペーストを印刷して矩形状の内部電極パターンを形成する。内部電極パターンとなる内部電極ペーストは、NiもしくはNiの合金粉末を主成分金属とし、これにセラミック粉末を混合し、有機バインダ、溶剤および分散剤を添加して調製する。内部電極ペースト中に添加するセラミック粉末としては、チタン酸バリウムを主体とする粉末を用いるのがよく、チタン酸バリウムを主体とする粉末としては、誘電体層 5 の誘電特性を損なわないという理由からチタン酸バリウム粉末もしくは誘電体粉末と同じ仮焼粉末を用いるのが好ましい。

### [0042]

50

10

20

30

次に、内部電極パターンが形成されたセラミックグリーンシートを所望枚数重ねて、その上下に内部電極パターンを形成していないセラミックグリーンシートを複数枚、上下層が同様の枚数になるように重ねて仮積層体を形成する。仮積層体中における内部電極パターンは長寸方向に半パターンずつずらしてある。このような積層工法により切断後の積層体の端面に内部電極パターンが交互に露出されるように形成できる。

[0043]

なお、この実施形態における積層セラミックコンデンサは、セラミックグリーンシートの主面に内部電極パターンを予め形成した後に積層する工法の他に、セラミックグリーンシートを一旦下層側の基材に密着させた後に、内部電極パターンを印刷していないセラミックグリーンシートを重ねて仮密着させ、セラミックグリーンシートの密着と内部電極パターンの印刷を逐次行う工法によっても形成できる。

[0044]

仮積層体を仮積層時の温度および圧力よりも高温、高圧の条件にてプレスを行い、セラミックグリーンシートと内部電極パターンとが強固に密着された積層体を形成する。

[0045]

次に、積層体を格子状に切断することにより内部電極パターンの端部が露出するコンデンサ本体成形体を形成する。

[0046]

次いで、得られたコンデンサ本体成形体を脱脂した後、焼成する。焼成は最高温度を1100~1200 、保持時間を1~3時間とし、水素・窒素の雰囲気中にて行う。焼成をこのような条件で行うことにより、仮焼粉末に対して後添加した Y b  $_2$  O  $_3$  ならびに D y  $_2$  O  $_3$  、 H o  $_2$  O  $_3$  および E r  $_2$  O  $_3$  から選ばれる少なくとも 1 種の希土類元素(R E ) の酸化物を誘電体層 5 へ拡散させることができ、誘電体層 5 を構成する誘電体磁器中に(Y b · R E)  $_2$  T i O  $_5$  相が結晶の状態で所定量含まれたコンデンサ本体 1 を得ることができる。

[0047]

この後、必要に応じて、900~1100 の温度範囲で窒素雰囲気中での加熱処理を行う。なお、必要に応じてコンデンサ本体1の稜線部分の面取りを行うとともに、コンデンサ本体1の対向する端面から露出する内部電極層7を露出させるためにバレル研磨を施しても良い。

[0048]

次に、このコンデンサ本体 1 の対向する端部に、外部電極ペーストを塗布して焼付けることにより外部電極 3 を形成して積層セラミックコンデンサを得ることができる。また、場合によっては、外部電極 3 の表面に実装性を高めるためにメッキ膜を形成しても良い。

[0049]

すなわち、この実施形態の積層セラミックコンデンサでは、誘電体層 5 が、チタン酸バリウムに、イットリウム、マンガン、マグネシウム、イッテルビウムと、ディスプロシウム、ホルミウムおよびエルビウムから選ばれる少なくとも 1 種の希土類元素(RE)とをを固溶させて、立方晶系を主体とする結晶相により構成されるものである。また、誘電体磁器中に(Yb・RE) 2 TiO 5 相を含有するようにしている。

[0050]

つまり、チタン酸バリウムに対して、イットリウム、マンガンおよびマグネシウムを所定量含有させると、室温(25 )以上のキュリー温度を示し、比誘電率の温度係数が正の値を示す誘電特性を示す誘電体磁器となる。また、このような誘電特性を示す誘電体磁器に対して、さらにイッテルビウムと、ディスプロシウム、ホルミウムおよびエルビウムから選ばれる少なくとも1種の希土類元素(RE)とを含有させた場合に、分極電荷を小さくすることができるのであるが、本発明は、これに加えて、誘電体磁器中に(Yb・RE)<sub>2</sub>Ti0<sub>5</sub>相を含有させることにより、高温において高い絶縁抵抗を長時間維持できる積層セラミックコンデンサを得ることができるのである。

10

20

30

40

### 【実施例】

### [0051]

いずれも純度が99.9%のBaCO $_3$ 粉末、TiO $_2$ 粉末、Y $_2$ О $_3$ 粉末、MnCO $_3$ 粉末およびYb $_2$ О $_3$ 粉末を用意し、表1に示す割合で調合し混合粉末を調製した。表1に示す量は前記元素の酸化物換算量に相当する量である。

### [0052]

次に、混合粉末を温度1000 にて仮焼し、仮焼粉末を粉砕した。このとき粉砕した仮焼粉末の平均粒径は0.1μmとした。なお、仮焼粉末の平均粒径は、まず、粉砕した仮焼粉末を電子顕微鏡用試料台上に分散させて走査型電子顕微鏡により写真を撮り、この後、その写真上で仮焼粉末が50~100個入る円を描き、円内および円周にかかった仮焼粉末を選択した。そして、その写真に映し出されている仮焼粉末の輪郭を画像処理して各粒子の面積を求め、同じ面積をもつ円に置き換えたときの直径を算出し、その平均値より求めた。

### [0053]

次に、仮焼粉末100質量部に対して、いずれも純度99.9%のMgO粉末、Yb $_2$  O $_3$  粉末、Dy $_2$  O $_3$  粉末、Ho $_2$  O $_3$  粉末、およびEr $_2$  O $_3$  粉末から選ばれる少なくとも1種の希土類元素(RE)の酸化物粉末を表1に示す割合で添加した。Yb $_2$  O $_3$  粉末は表1に示す比表面積を有するものを用い、MgO粉末は比表面積が8 $m^2$  /gのものを用いた。また、焼結助剤として、SiO $_2$ を主成分とするガラス粉末(SiO $_2$ :40~60モル%、BaO:10~30モル%、CaO:10~30モル%、Li $_2$  O:5~15モル%)を添加した。ガラス粉末の添加量は、仮称粉末100質量部に対して3質量部とした。

### [0054]

この後、Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粉末およびMgO粉末を加えた仮焼粉末とガラス粉末との混合粉末を、トルエンおよびアルコールの混合溶媒中に投入し、直径1mmのジルコニアボールを用いて湿式混合してセラミックスラリを調製し、ドクターブレード法により厚み13µmのセラミックグリーンシートを作製した。

#### [0055]

次に、このセラミックグリーンシートの上面にNiを主成分とする矩形状の内部電極パターンを複数形成した。内部電極パターンを形成するための導体ペーストは、平均粒径が0.3 μmのNi粉末100質量部に対して、微粉砕した仮焼粉末を添加したものを用いた。仮焼粉末の添加量は導体ペーストに用いる金属粉末を100質量部としたときに15質量部とした。

### [0056]

次に、内部電極パターンを印刷したセラミックグリーンシートを100枚積層し、その上下面に内部電極パターンを印刷していないセラミックグリーンシートをそれぞれ20枚積層し、プレス機を用いて温度60 、圧力10<sup>7</sup>Pa、時間10分の条件で密着させて積層体を作製し、しかる後、この積層体を、所定の寸法に切断してコンデンサ本体成形体を形成した。

### [0057]

次に、コンデンサ本体成形体を大気中で脱バインダ処理した後、水素 - 窒素中、 1 1 5 0 ~ 1 3 5 0 で焼成した。作製したコンデンサ本体は、続いて、窒素雰囲気中 1 0 0 0 で 4 時間再酸化処理を行った。このコンデンサ本体の大きさは 3 . 1 × 1 . 5 × 1 . 5 m m  $^3$  、誘電体層の厚みは 1 0  $\mu$  m、内部電極層の 1 層の有効面積は 1 . 2 m m  $^2$  であった。なお、有効面積とは、コンデンサ本体の異なる端面にそれぞれ露出するように積層方向に交互に形成された内部電極層同士の重なる部分の面積のことである。

### [0058]

次に、焼成したコンデンサ本体をバレル研磨した後、コンデンサ本体 1 の両端部に C u 粉末とガラスとを含んだ外部電極ペーストを塗布し、 8 5 0 で焼き付けを行って外部電極を形成した。その後、電解バレル機を用いて、この外部電極の表面に、順に N i メッキ

10

20

30

40

10

20

30

40

50

及びSnメッキを行い、積層セラミックコンデンサを作製した。

### [0059]

次に、これらの積層セラミックコンデンサについて以下の評価を行った。比誘電率および分極電荷の評価はいずれも試料数50個とし、室温(25 )における比誘電率は静電容量をLCRメータ(ヒューレットパッカード社製)を用いて、温度25 、周波数1.0kHz、測定電圧を1Vrmsとして測定し、誘電体層の厚みと内部電極層の有効面積から求めた。

### [0060]

また、得られた積層セラミックコンデンサの分極電荷は電気誘起歪の大きさを誘電分極の測定によって求めた。この場合、電圧を±50Vの範囲で変化させた時の、0Vにおける電荷量(残留分極)の値を分極電荷として評価した。また、積層セラミックコンデンサを温度125 に保持し、1分以内の絶縁抵抗をR0、同温度で10時間経過時の絶縁抵抗をR1としたときに、次式:((R1-R0)/R0)×100(%)で表される高温での絶縁抵抗の変化率を求めた。また、温度:140 、直流電圧:150V、保持時間:20時間の条件の高温負荷試験を行って、高温負荷寿命を求めた。

#### [0061]

また、得られた積層セラミックコンデンサを粉砕し、X線回折(PANalytica 1 社製 X 'Pert PRO 2 = 10~120°、Cu-K 1、出力45kV 0 m A )を用いて結晶相の同定を行った。結晶相の定量は、リートベルト法による解析に より精密化した。リートベルト法は解析ソフトRIETANにより解析した。結晶構造モ デルは、以下に示すモデルをそれぞれ用いた。BaTiO 。( tetragonal: P 4 m m , N o . 9 9 ) 、 N i ( c u b i c : F m - 3 m 、 N o . 2 2 5 ) 、 Y b <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ま taly 2 O 3 (cubic: Ia - 3、No. 206)、Yb 2 TiO 5 (cubic: F-43m、No.216)、MgO(cubic:Fm-3m、No.225)、Ba O (tetragonal: P4/nmm、No.129)、Ba, TiSi, O, (c ubic:tetragonal:P4bn、No.100)。なお、解析にあたっては Y b ヵTi0 ₅ 相の結晶ピークを基準にして、そのピークシフト量を元に、格子定数の 変化が認められることを確認するとともに、結晶粒子の断面について、分析装置(EDS )を備えた透過電子顕微鏡を用いて、結晶粒子中に含まれる元素として、YbとTiと、 Dy、HoおよびErから選ばれる少なくとも1種の希土類元素(RE)を含んでいるこ とを確認して、誘電体磁器中に含まれている結晶相が(Yb・RE)っTiOg相である ことを同定した。

#### [0062]

誘電体層を構成する結晶粒子の平均粒径は、焼成後のコンデンサ本体である試料の破断面を研磨した後、走査型電子顕微鏡を用いて内部組織の写真を撮り、その写真上で結晶粒子が50~100個入る円を描き、円内および円周にかかった結晶粒子を選択し、各結晶粒子の輪郭を画像処理して、各粒子の面積を求め、同じ面積をもつ円に置き換えたときの直径を算出し、その平均値より求めた。

### [0063]

また、得られた焼結体である試料の組成分析はICP(Inductively Coupled Plasma)分析および原子吸光分析により行った。この場合、得られた誘電体磁器を硼酸と炭酸ナトリウムと混合し溶融させたものを塩酸に溶解させて、まず、原子吸光分析により誘電体磁器に含まれる元素の定性分析を行い、次いで、特定した各元素について標準液を希釈したものを標準試料として、ICP発光分光分析にかけて定量化した。また、各元素の価数を周期表に示される価数として酸素量を求めた。

### [0064]

調合組成および焼成条件を表1に、焼結体中の各元素の酸化物換算での組成および X 線回折チャート上の(Y b・R E) 2 T i O 5 相の有無を表2に、結晶粒子の平均粒径、 X 線回折リートベルト法により求まる(Y b・R E) 2 T i O 5 相の含有量および焼成後における特性(比誘電率,分極電荷、高温での絶縁抵抗の変化率および高温負荷寿命特性の

# 結果を表3にそれぞれ示す。

# [0065]

# 【表1】

500 PM to -		Balモルに対	†8 <b>±</b>		仮焼粉末への先添加 (仮焼粉末100買量部 に対する系加量)			(添加 可量部 量)		換成溫自	
試MNa.	YO <sub>3-1</sub>	MnCO <sub>3</sub>	тю,	MgO	Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Yb <sub>7</sub> O <sub>1</sub>	Yb-O-の 比表面物	希土類元素			MgO
	モル	モル	モル	モル	質量部	質量部	m²/g	種類	質量部	黄量部	°C
* 1	0.01	0.03	0.99	0	2.5	2.50	6.80	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.00	0.17	1150
2	0.01	0.03	0.99	0	0.3	0.15	120	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.15	0.17	1150
3	0.01	0.03	0.99	0	1.0	0.50	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.50	0.17	1150
4	0.01	0.03	0.99	0	1.3	0.63	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.63	0.17	1150
5	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
6	0.01	0.03	0.99	0	3.8	1.90	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,90	0.17	1150
7	0,01	0.03	0.99	0	5.0	2.50	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.50	0.17	1250
8	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	5.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
9	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	8.2	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
10	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	18.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
11	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	27.5	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
12	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	31.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
13	0.0004	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
14	0.005	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
15	0.03	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
16	0.06	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
17	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1050
18	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1350
19	0.01	0	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
20	0.01	0.02	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
21	0.01	0.04	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
22	0.01	0.05	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
23	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
24	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0			0.065	
25	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.003	1150
	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.13	1150
27	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0		1.25	0.34	1150
28	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy₂O₃			
29	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.38	1150
30	0.01	0.02		0		1.25		Dy <sub>2</sub> Q <sub>3</sub>	1.25	+	1150
31	0.01	0.03	0.99	0	2.5 2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.13	1150
								Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.15	0.17	1150
32	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.50	0.17	1150
			0.99			1.25		Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.50	0.17	1150
34	0.01	0.03	<u> </u>	0	2.5	1.25	12.0	Dy₂O <sub>3</sub>	3.00	0.17	1150
35	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.00	0.17	1150
36	0.01	0.03	0.99	0	2.5	0.15	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
37	0.01	0.03	0.99	0	2.5	0.50	12.0	Dy₂O₃	1.25	0.17	1150
38	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.50	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
39	0.01	0.03	0.99	0	2.5	3.00	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
40	0.01	0.03	0.99	0	2.5	5.00	12.0	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
41	0.01	0.03	0.99	0	2.5	1.25	12.0	Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150
42	10.0	0.03	0.99	0	2.5	F.25	12.0	Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	0.17	1150

<sup>\*</sup> 印は本発明の範囲外の試料を示す。

[0066]

10

20

30

# 【表2】

				ヤート上の iO <sub>5</sub> 結鼻根					
試料No.	YO <sub>3/2</sub>	MnO	TIO,	MgO	Yb0 <sub>3/2</sub>	希土類元素	REO <sub>3/2</sub>	Yb <sub>2</sub> TiO <sub>5</sub>	(YDRE) <sub>z</sub> TiO <sub>5</sub>
	モル	モル	モル	モル	モル	種類	モル	有:O. 無: ×	有: O, 無: ×
* 1	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>1/2</sub>	0.020	0	×
2	0.010	0.030	0.99	0.020	0.015	DyO <sub>3/2</sub>	0.005	×	0
3	0.010	0.030	0.99	0.020	0,019	DyO <sub>3/2</sub>	0.006	×	0
4	0.010	0.030	0.99	0.020	0.032	DyO <sub>3/2</sub>	0,011	×	0
5	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/3</sub>	0.020	×	0
6	0.010	0.030	0.99	0.020	0.090	DyO <sub>1/2</sub>	0.030	×	0
7	0.010	0.030	0.99	0.020	0.120	DyO <sub>3/2</sub>	0.040	×	0
8	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
9	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
10	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
11	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyD <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
12	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
13	0,0004	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
14	0.005	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0,020	×	0
15	0.03	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>1/2</sub>	0.020	×	0
16	0.060	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>1/2</sub>	0.020	×	0
17	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
18	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
19	0.010	0.000	0.99	0.020	0.019	DyO <sub>3/2</sub>	0.006	×	0
20	0.010	0.020	0.99	0.020	0.019	DyO <sub>3/2</sub>	0.006	×	0
21	0.010	0.040	0.99	0.020	0.019	DyO <sub>3/2</sub>	0.006	×	0
22	0.010	0.050	0.99	0.020	0.019	DyO <sub>3/2</sub>	0.006	×	0
23	0.010	0.030	0.99	0.005	0.019	DyO <sub>3/2</sub>	0,006	×	0
24	0.010	0.030	0.99	0.0075	0.019	DyO <sub>3/2</sub>	0.006	×	0
25	0.010	0.030	0.99	0.015	0.019	DyO <sub>1/2</sub>	0,006	×	0
26	0.010	0.030	0.99	0.030	0.019	DyO <sub>3/2</sub>	0.006	×	0
27	0.010	0.030	0.99	0.040	0.019	DyO <sub>3/2</sub>	0.006	×	0
28	0.010	0.030	0.99	0.045	0.019	DyO <sub>1/2</sub>	0.006	×	0
29	0.010	0.020	0.99	0.020	0.060	DyÖ <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
30	0.010	0.030	0.99	0.015	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
31	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.002	×	0
32	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.007	×	0
33	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.023	×	0
34	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.050	×	0
35	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	DyO <sub>3/2</sub>	0.080	×	0
36	0.010	0.030	0.99	0.020	0.007	DyO <sub>3/1</sub>	0,020	×	0
37	0.010	0.030	0.99	0.020	0.025	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
38	0.010	0.030	0.99	0.020	0.075	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
39	0.010	0.030	0.99	0.020	0.145	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
40	0.010	0.030	0.99	0,020	0,240	DyO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
41	0.010	0,030	0,99	0.020	0.060	HoO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0
42	0.010	0.030	0.99	0.020	0.060	ErO <sub>3/2</sub>	0.020	×	0

\* 印は本発明の範囲外の試料を示す。

[ 0 0 6 7 ]

10

20

30

### 【表3】

	求まる(YbxREt=x) <sub>x</sub> TIO <sub>5</sub> の含有量	主統品教子 の 平均教得	比狭電車 (Ex)	分極電荷	高温での親醫妊抗 の変化率 <sup>®</sup>	高温黄荷寿命""	
	Ba1モルに対する里(モル	μm	-	nC/cm²	96	-	
* 1	0	0.16	870	23	-101	×	
2	0.0015	0.18	1272	40	-93	×	
3	0.0025	0.17	1007	28	-75	0	
4	0.0033	0.16	965	25	-72	0	
5	0.0050	0.15	922	24	-67	0	
6	0.0080	0.11	795	22	~65	0	
7	0.0125	0.10	731	20	-63	0	
8	0.0016	0.17	965	26	-89	0	
9	0.0035	0.17	933	22	-88	0	
10	0.0065	0.16	912	21	-86	0	
11	0.0080	0.15	906	21	-75	0	
12	0.0085	0.22	875	23	-70	0	
13	0.0037	0.26	954	37	-73	0	
14	0.0040	0.19	928	24	-65	0	
15	0.0060	0.14	885	35	-64	0	
16	0.0080	0.07	870	32	-62	0	
17	0.0053	0.05	583	19	-59	0	
18		0.27	<del></del>	<del> </del>		×	
	0.0053		1696	50	-91		
- 19	0.0025	0.16	954	36	-75	0	
20	0.0025	0.18	880	28	-69	0	
21	0.0025	0.18	B16	26	-63		
22	0,0024	0.17	636	25	-58	0	
23	0.0025	0.18	986	36	-79		
24	0.0025	0.17	901	28	-66	0	
25	0.0025	0.15	869	26	-65	0	
26	0.0025	80.0	823	26	-65	0	
27	0.0025	0.08	784	25	-67	0	
28	0.0025	0.08	695	25	-62	0	
29	0.0050	0.15	933	25	-66	0	
30	0.0050	0.15	928	25	-64	0	
31	0.0003	0.18	954	26	-95	×	
32	0.0020	0.17	943	25	<b>68</b>	0	
33	0.0060	0.15	928	24	-65	0	
34	0.0080	0.13	890	23	-63	0	
35	0.0100	0.11	784	22	-60	0	
36	0.0003	0.20	949	30	-95	×	
37	0.0020	0.17	938	28	-65	0	
38	0.0060	0.15	922	26	-63	0	
39	0.0080	0.13	890	25	-62	0	
40	0.0100	0.11	721	24	+60	0	
41	0.0050	0.15	921	24	-67	0	
42	0.0050	0.15	920	24	-67		

#:温度:125℃、温度125℃に保持したときの、1分以内の絶縁抵抗をR0、同温度で10時 耐軽過時の絶縁抵抗をR1としたときに、次式:((R1−R0)/R0)×100(%)で表される値

##:温度:140℃、直流電圧:150V、保持時間:20時間

## [ 0 0 6 8 ]

表 1 ~ 3 の結果から明らかなように、本発明の誘電体磁器である試料 N o . 2 ~ 4 2 では、高温での絶縁抵抗の変化率が - 9 5 %以内となり、高温負荷寿命に優れた低電歪特性を有する積層セラミックコンデンサが得られた。

10

20

30

[0069]

また、誘電体層の X 線回折分析のリートベルト法解析において、バリウム 1 モルに対する前記( Y b・R E )  $_2$  T i O  $_5$  相の含有量を 0 . 0 0 1 6 モル以上とした試料 N o . 3 ~ 3 0 , 3 2 ~ 3 5 および 3 7 ~ 4 0 では、高温での絶縁抵抗の変化率が - 9 3 % 以内であった。

[0070]

さらに、誘電体層を構成する結晶粒子の平均粒径が 0 . 0 7 ~ 0 . 2 6 μ m とした試料 N o . 3 ~ 1 6 , 1 9 ~ 3 0 , 3 2 ~ 3 5 および 3 7 ~ 4 0 では、室温(2 5 )における比誘電率が 7 2 1 以上、分極電荷が 3 6 以下、高温での絶縁抵抗の変化率が 8 9 % 以下であり、温度: 1 2 5 、直流電圧: 2 0 0 V、保持時間: 2 0 時間の条件の高温負荷寿命を満足するものとなった。

[0071]

またさらに、誘電体層 5 を構成する結晶粒子の平均粒径を 0 . 0 8 ~ 0 . 2 2 μ m とし、積層セラミックコンデンサを酸に溶解させて求められる元素の含有量が、バリウム 1 モルに対して、イットリウムが Y O 3 / 2 換算で 0 . 0 0 1 4 ~ 0 . 0 3 モル、マンガンが M n O 換算で 0 . 0 0 0 2 ~ 0 . 0 4 5 モル、マグネシウムが M g O 換算で 0 . 0 0 7 5 ~ 0 . 0 4 モル、イッテルビウムが Y b O 3 / 2 換算で 0 . 0 2 5 ~ 0 . 1 4 モル、希土類元素(RE)が 0 . 0 0 6 ~ 0 . 0 5 モルであり、かつ誘電体層の X 線回折分析のリートベルト法解析において、バリウム 1 モルに対する前記(Y b ・ R E) 2 T i O 5 相の含有量が 0 . 0 0 2 4 ~ 0 . 0 0 8 モルである試料 N o . 3 ~ 6 , 9 ~ 1 1 , 1 4 , 1 5 , 1 8 , 2 0 , 2 1 , 2 4 ~ 2 6 2 9 , 3 0 , 3 2 ~ 3 4 および 3 7 ~ 4 0 では、室温(2 5 )における比誘電率が 7 9 5 以上、分極電荷が 2 8 n C / c m 2 以下、高温での絶縁抵抗の変化率が - 8 8 %以内であるとともに、温度: 1 4 0 、直流電圧: 1 5 0 V、保持時間: 2 0 時間の条件の高温負荷寿命を満足するものとなった。

[0072]

これに対して、本発明の範囲外の試料No.1では、高温での絶縁抵抗の変化率が-101%であり、高温負荷寿命が低いものとなった。

【符号の説明】

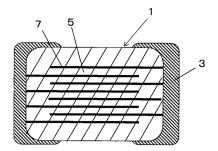
[0073]

- 1 コンデンサ本体
- 3 外部電極
- 5 誘電体層
- 7 内部電極層

10

20

【図1】



## フロントページの続き

F ターム(参考) 5E082 AA01 AB03 BB07 BC23 BC35 EE04 EE26 EE35 FF05 FG04

FG26 FG46 FG54

5G303 AA01 AB01 AB11 AB14 BA01 BA06 BA09 CA01 CB03 CB17

CB18 CB35 CB40 CB41 CB43